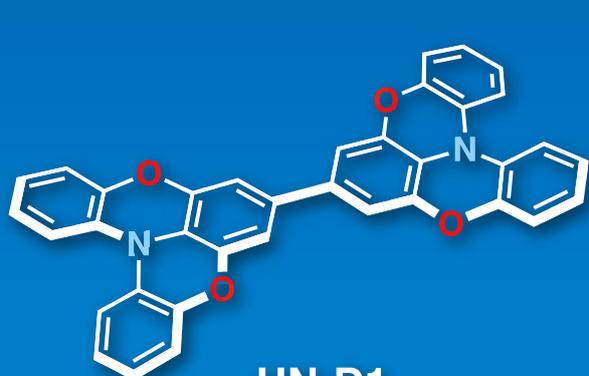
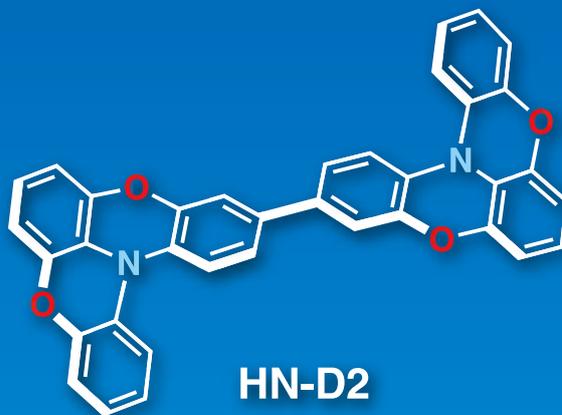


伪平面空穴导体：HN-D



HN-D1
[B4908]

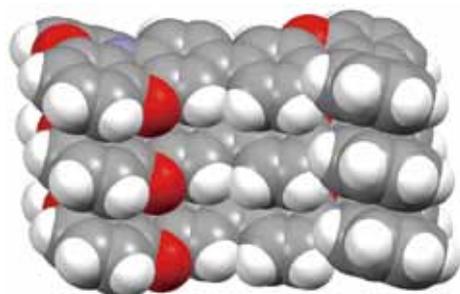


HN-D2
[B4907]

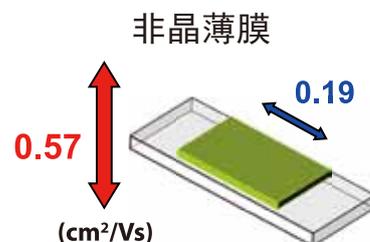
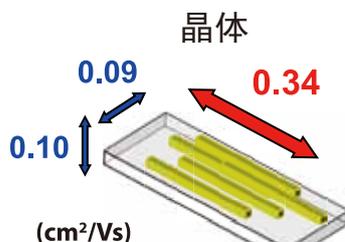
优势

- 晶体中由一维排列的分子构成的顶部 π -堆积结构
- 非晶薄膜中的各向异性迁移率
- 非晶薄膜在垂直于器件层的方向上显示出高的载流子迁移率

应用



载流子迁移率各向异性 (B4907)



(通过TRMC方法)

A. Wakamiya, H. Nishimura, T. Fukushima, F. Suzuki, A. Saeki, S. Seki, I. Osaka, T. Sasamori, M. Murata, Y. Murata, H. Kaji, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2014**, 53, 5800-5804.
A. Wakamiya, H. Nishimura, Y. Murata, T. Fukushima, H. Kaji, Kyoto University, JP Patent 5591996.

HN-D1 (= 7,7'-Bi[1,4]benzoxazino[2,3,4-k']phenoxazine)

200mg [B4908]

HN-D2 (= 3,3'-Bi[1,4]benzoxazino[2,3,4-k']phenoxazine)

200mg [B4907]

这些产品在与京都大学化学研究所的Atsushi Wakamiya教授合作下实现了商业化。

更多信息, 请查看我们的主页: www.TCIchemicals.com

空穴传输



梯希爱(上海)化成工业发展有限公司
www.TCIchemicals.com

询价与订购联系方式:

电话: 800-988-0390/021-6712-1386

传真: 021-6712-1385 邮件: Sales-CN@TCIchemicals.com

地址: 上海化学工业区普工路96号 邮编: 201507